

半导体学报

第 14 卷 第 5 期 1993 年 5 月

目 录

- 金属包层五层介质光波导的模吸收损耗..... 马春生 曹 杰 刘式墉(265)
- 浮区中相变对流和毛细对流对分凝过程的影响..... 熊 斌 胡文瑞(270)
- 短沟道薄膜全耗尽 SOI/MOSFET's 大信号电容模型 程玉华 王阳元(278)
- GaAs 对称定向耦合光开关的研究 冯 浩 李锡华 王明华 吴志武(286)
- 考虑碰撞电离下的亚微米 MOSFET 的二维数值模拟和分析
..... 张锡盛 何新平 李志坚(292)
- 沟道大电流感应 n 沟金属-氧化物-半导体场效应晶体管栅氧化层的加速击穿
..... 黄美浅 黎沛涛 马志坚 郑耀宗 刘百勇 李观启(297)
- GaAs 电学参数温度性质的研究 张声豪(304)
- 研究简报**
- LPCVD 氮化硅膜的表面氧化对 pH-ISFET 特性影响的研究 牛文成(313)
- Yb、Er 双注入 SI-InP 发光中的浓度猝灭效应和光子雪崩现象研究
..... 曹望和 张联芬(318)
- 研究快报**
- 发光多孔硅高分辨电镜分析
..... 鲍希茂 闫 锋 柳承恩 郑祥钦 王路春 朱健民 李 齐(322)
- a-Si:H 中光致亚稳缺陷产生的弛豫过程:HCR 和 DCR 模型的实验检验
..... 孙国胜 孔光临(325)